



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
25.07.2001 Patentblatt 2001/30

(51) Int Cl.7: **H01P 1/10**, H01P 3/08,
H01P 5/04, H01P 7/08

(43) Veröffentlichungstag A2:
02.02.2000 Patentblatt 2000/05

(21) Anmeldenummer: **99113897.5**

(22) Anmeldetag: **16.07.1999**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **25.07.1998 DE 19833512**

(71) Anmelder: **DaimlerChrysler AG
70567 Stuttgart (DE)**

(72) Erfinder:
• **Wenger, Josef, Dr.
89250 Senden (DE)**
• **Stotz, Michael
89173 Lonsee (DE)**
• **Downar, Hartmut, Dr.
88709 Hagnau (DE)**
• **Scherber, Werner, Dr.
88697 Bermatingen (DE)**

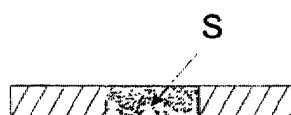
(54) **Aktives Hochfrequenzsteuerelement**

(57) Die Erfindung betrifft eine aktives HF-Steuer-
element, mit

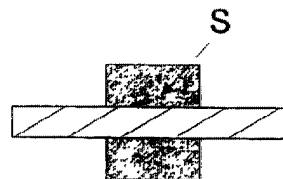
- einem HF-tauglichen Substrat, sowie einer darauf
angebrachten HF-Leitungsanordnung;
- einem auf dem Substrat befindlichen Steuer-

schicht, deren elektrische Leitfähigkeit durch Tem-
peraturänderung steuerbar ist, wobei die Steuer-
schicht an mindestens einer Stelle mit der HF-Lei-
tungsanordnung gekoppelt ist,

- Mittel zur Temperaturänderung der Steuerschicht.



(a)



(b)

Fig. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 3897

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	SOVERO E ET AL: "FAST THIN FILM VANADIUM DIOXIDE MICROWAVE SWITCHES" PROCEEDINGS OF THE GALLIUM ARSENIDE INTEGRATED CIRCUIT SYMPOSIUM. (GAAS IC),US,NEW YORK, IEEE, Bd. SYMP. 12, 7. Oktober 1990 (1990-10-07), Seiten 101-103, XP000223249 * das ganze Dokument *	1,2,4, 6-9	H01P1/10 H01P3/08 H01P5/04 H01P7/08
Y	---	3,5	
Y	US 4 906 956 A (KAKIHANA) 6. März 1990 (1990-03-06) * das ganze Dokument *	3,5	
X	--- V.E. ORLOV ET AL.: "MICROWAVE PROPAGATION IN A SLOT TRANSMISSION LINE CONTAINING A THERMALLY CONTROLLABLE FILM OF VANADIUM OXIDES" SOVIET TECHNICAL PHYSICS LETTERS., Bd. 9, Nr. 5, Mai 1983 (1983-05), Seiten 224-225, XP001006275 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK., US ISSN: 1063-7850 * das ganze Dokument *	1,2,4, 6-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) H01P
A	--- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 292 (E-782), 6. Juli 1989 (1989-07-06) & JP 01 072601 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 17. März 1989 (1989-03-17) * Zusammenfassung *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 5. Juni 2001	Prüfer Den Otter, A
KATEGORIE DER GENANTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 3897

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-06-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4906956	A	06-03-1990	JP 2029002 A	31-01-1990
JP 01072601	A	17-03-1989	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82